

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 25 年 2 月 28 日 (2013.2.28)

【公開番号】特開 2011-146506 (P2011-146506A)
 【公開日】平成 23 年 7 月 28 日 (2011.7.28)
 【年通号数】公開・登録公報 2011-030
 【出願番号】特願 2010-5749 (P2010-5749)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 21/683 (2006.01)

H 0 1 L 21/205 (2006.01)

C 2 3 C 16/458 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/68 N

H 0 1 L 21/205

C 2 3 C 16/458

【手続補正書】

【提出日】平成 25 年 1 月 9 日 (2013.1.9)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

全面に SiC の被覆層を備えるグラファイトカーボンを基材とするサセプタの表面全面を、ガラス状カーボンで被覆したことを特徴とする、気相成長装置用サセプタ。

【請求項 2】

SiC を基材とするサセプタの表面全面又は少なくともウェーハ支持部を、ガラス状カーボンで被覆したことを特徴とする、気相成長装置用サセプタ。

【請求項 3】

ガラス状カーボンのショア硬度が、100～1500HSであることを特徴とする、請求項 1 又は 2 に記載の気相成長装置用サセプタ。

【請求項 4】

前記ガラス状カーボン膜の厚みが、2～40 μm である、請求項 1～3 のいずれか一項に記載の気相成長装置用サセプタ。

【請求項 5】

前記ウェーハ支持部のウェーハ支持面を、該サセプタのザグリ部の外周側から中心に向かって低くなるように、2°以下の角度で傾斜させたことを特徴とする、請求項 1～4 のいずれか一項に記載の気相成長装置用サセプタ。

【請求項 6】

前記ウェーハが、直径 300mm 以上のシリコンウェーハであることを特徴とする、請求項 1～5 のいずれか一項に記載の気相成長装置用サセプタ。

【請求項 7】

請求項 1～6 のいずれか一項に記載の気相成長装置用サセプタを用いた、気相成長装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0009】

本発明は、上記の知見に基づくもので、その要旨構成は、次の通りである。

(1) 全面にSiCの被覆層を備えるグラファイトカーボンを基材とするサセプタの表面全面を、ガラス状カーボンで被覆したことを特徴とする、気相成長装置用サセプタ。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0010】

(2) SiCを基材とするサセプタの表面全面又は少なくともウェーハ支持部を、ガラス状カーボンで被覆したことを特徴とする、気相成長装置用サセプタ。